Searching PAJ Page 1 of 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-162414

(43)Date of publication of application: 16.06.2000

(51)Int.Cl.

G02B 5/10 603F 7/20 H01L 21/027

(21)Application number: 11-267312 (22)Date of filing:

21.09.1999

(71)Applicant: NIKON CORP

(72)Inventor: TAKINO HIDEO SHIBATA NORIO

(30)Priority

Priority number: 10268581

Priority date: 22.09.1998

Priority country: JP

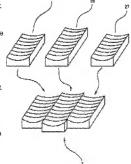
(54) MANUFACTURE OF REFLECTION MIRROR REFLECTION ILLUMINATING DEVICE OR SEMICONDUCTOR EXPOSING DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture a multiple light source forming reflection mirror with a reflection surface shape precisely copying a designed one at a good yield by machining a line of element reflection surfaces on each base board in formation of the element reflection surface lines and connecting the base boards provided with the formed element reflection face lines to each other.

SOLUTION: Three kinds of element reflection surface shapes are shaped and polished one by one for mirrorfinishing the element reflection surface. In this way, element, reflection surface lines 25-27, in each of which three kinds of element reflection surfaces are arranged repeatedly in one direction on a single base board, are formed. A surface shape of each element reflection surface is provided with a shape formed when a predetermined shape is projected to a recessed surface having a fixed curvature. The element reflection surface lines 25-27 are arranged orthogonally to the element reflection surface line forming direction for sticking the base boards together, and consequently, a

multi-surface reflection mirror 2 is formed. In the formed multi-surface reflection mirror 2, a reflection film is formed for further improving a reflectance.



(51) Int C17

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

TГТ

(11)特許出願公開番号

特開2000-162414 (P2000-162414A)

テーフフェル* (金米)

(43)公開日 平成12年6月16日(2000, 6, 16)

| (51) Int.CL. | 碱別配号 | P I | 7~{J~} (|
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| G 0 2 B 5/10 | | G 0 2 B 5/10 | С |
| G03F 7/20 | 5 2 1 | G03F 7/20 | 5 2 1 |
| H01L 21/027 | | H 0 1 L 21/30 | 515D |
| | | | 5 1 7 |
| | | | 5 3 1 A |
| | | 客查請求 未請求 | 計球項の数5 OL (全 9 頁) |
| (21)出願番号 | 特願平11-267312 | (71)出願人 000004112 株式会社ニコン | |
| (22)出順日 | 平成11年9月21日(1999.9.21) | 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 (72)発明者 瀬野 日出雄 | |
| (31)優先権主張番号 (32)優先日 | 特願平10-268581 平成10年9月22日(1998.9.22) | 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内 | |
| (33)優先権主張国 | 日本 (JP) | (72)発明者 柴田 | 規夫 |
| | | | 千代田区丸の内3丁目2番3号 株 ニコン内 |

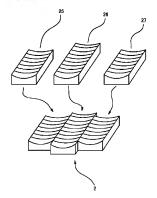
(54) 【発明の名称】 反射鏡の製造方法又は反射型照明装置又は半導体露光装置

经可约只

(57)【要約】

【課題】 本発明は、設計通りの反射面形状を有する多 光源形成反射鏡を歩留まり良く製造できる製造方法を提 供することを第1の目的にし、更には、よりスループッ トの高い半導体露光装置を得ることを第2の目的にして いる。

【解決手段】 本発明では、所定の曲面の一部を面形状 とする要素反射面を複数形成し、所定の位置に配置して なる反射鏡の製造方法であって、複数の基板を用意し、 各基板に要素反射面を一列づつ加工して要素反射面列2 5、26、27を形成し、要素反射面列25、26、2 7が形成された基板同士を接合する工程を有することと した。



【特許請求の範囲】

【請求項1】所定の曲面の一部を面形状とする要素反射 面を複数形成し、所定の位置に配置してなる反射鏡の製 造方法であって、

複数の基板を用意し、各基板に前記要素反射面を一列づ つ加工して要素反射面列を形成し、前記要素反射面列が 形成された基板同士を接合する工程を有することを特徴 とする多面反射錠の製造方法。

【請求項2】 前記要素反射面が凹面形状を有し、かつ 前記要素反射面列が形成された基板同士は、前記要素反 射面列がなす方向に対して異なる方向に接合することを 物像とする請求項 (評載の多面反射線の製造方法、

【請求項3】 所定の曲面の一部を面形状とする要素反 射面を複数形成し、所定の位置に配置してなる反射型照 明装置であって、

前記要素反射面が一列づつ形成された複数の基板をそれ ぞれ接合したことで形成された反射型照明装置。

【請次項 4】光減、マスクを保持して移動するマスクス テージ、該マスクを照明する限明光学系、該マスク上の パターンをウェハ上に没能する登影光学系、ウェハを保 持して移動させるウェハステージを有する半等体調光速 歴であって、前記照明光学系の一部に請求項 記載の反 射型照明装備を有し、前記家美反射記(前記投影光学系 の光学規野と相似形であることを特徴とする半等体露光 装置。

【請求項5】請求項4記載の半導体曙光装置であって、 該反射型照明装置の各々の反射面は円弧形状であること を特徴とする半導体露光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、反射線の製造方法 及び半導体製造装置に関するものであり、特には、微小 な要素反析心を所定の位置に数数量、配列することによ り構成される反射鏡の製造方法、反射型原明装置、更に はその原則装置を用いた半等体露光装置に関するもので ある。

[0002]

【従来の技術】現在、DRAMやMCP 等の半導体デバイスの製造においては、最小線幅をより狭くする開発研 完が底んに行われており、デザインルール 0.13μ m (4 G・DRAM相当)、0.1μm (16 G・DR AM相当)、更には0.07mμ (32 G・DRAM相 9)の実現に向けて確々の技術が開発されてみる相

【0003】この最小海縁心問題と切っても切れない側 係を有するのが、露光時に生じる光の回ň現象であり、 これに起関する像や集光点のボケが必要な魚・緑縞を実 現する時の最大の問題点である。この回析現象の影響を 押さえるためには露光光学系の関ロ数 (N.A.: Numerical aperture)を大きくする必要があり、光学系の大口径化 と数長の施設化が開発のポイントになっている。 【0004】ところが、光心設長が短くなると、物に2 00 nm以下になると、加工が容易で、光景吸の少ない 光学科料が思急たらなくなってくる。そこで、透過光学 系を捨てて、反射光学系による受影光学系の開発がなさ れており、相当な成果を上げている。その中に、複数の 反射鏡の組み合わせによって、軟、線に対して円弧状の 光学視野「震光鏡域として使用出来る領域)を実現し、 マスクとウェーを受影縮小率比の相対速度で、互いに同 側して移動させることによってチップ全体を震光しよう とする方法がある(例えば、Koichiro Hoh and Hiroshi Tanino; "Feasibility Study on the Extreme UV/Soft ** Texp Projection-type Lithography"。 Balletia of the electrontechnical Laboratory Vol. 49, No.12, P.9 83-990, 1985。を参照。なお、この文敵を以後、参考文敵 1と記すり、

【0005】ところで、最小線幅と並んで上記の様な半 導体デバイス製造にとって重要な要素にいわゆるスルー プットがある。このスループットに関与する要因として は、光源の発光強度、照明系の効率、反射系に使用する 反射鏡の反射率、ウェハ上の感光材料・レジストの感度 等がある。現在、光源としては、ArFレーザー、F。 レーザー、更に短波長光の光源としてシンクロトロン放 射光やレーザープラズマ光がある。また、これらの光を 反射する反射鏡に関しても、高い反射率が得られるよう に多層膜反射鏡の開発も急ピッチで行われている(詳細 は前述の参考文献 1、及び、Andrew M. Hawryluk et al ; "Soft x-ray beamsplitters and highly dispersive multilayer mirrors for use as soft x-ray laser ca vity component", SPIE Vol. 688 Multilayer Struct ure and Laboratory X-ray Laser Research (1986) P. 8 1-90 及び、特開昭63-312640を参照)。

【0006】さ、半導体療・装置についてであるが、この半導体電光装置には、ムラ無く均一に原版を照明するために、光酸の光量分布がどうであれ均一に原版に照 学系に要求されるものは、一様照明性や開口性である。 例えば特明館60-232552号金線には、矩形形状の照明領域を対象とした技術が提案されている。しかし、半導体電光装置は、原版のパランンをウェハ上に形が、内重がする投影学系を領点でおり、この投影・光等の利用が、の用紙状である場合、照明視野が矩形形状では光の利用効率が悪く、どうしても確認で調査と振伸出来ず、従って、スループットが上がらなかった。

【0007】最近、この問題を解決する方法として、投 影光学系の有する光学視野に合かせて原明視野を設定 し、この原例視野に光源からの光を集光する方法とし て、例えば、特開平10-70058「X線縮小投影響 光装蔵及びこれを用いた半導体デバイス製造装置」が提 楽されている。これは、照明光学系として図12に示シ シリンドリカル形状の反射電売前半円柱壁インテグレー タが用いられている。反射型色面半円柱型インテグレー クーは、微小な凸半円柱面を1次元に多数配置した形状 の反射面を移っ全反射ミラーである。また、反射型凸面 半円柱型インテグレータの代わりに、図13に示すよう な反射型凹面半円柱型インテグレータを用いることもで きる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記のような反対鏡は通常、一つの素板を被加工物をして、ボー エンドミルを備えた切削加工機を用いて切削加工により 製作される。ボールエンドミルは図14(a)に示すような形状であり、その位置を被加工物に対して3次元的 に加加することによって、同図(b)のように色々な面 の加工が可能である。

【0009】 しかし、一つのアルミニウム基底から、図 2 2 に示した反射面形状を形成し、出来上がった多光線 形成反射旋差用いて実際に限明してみると、 予期した良 好な反射効率を有するインテクレータが形成されず、こ のようなインテグレータを用いた半導体震光装置では、 高いスループットが得られなかった。そこで、その原因 を追究したところ、図 15 に示すように、 凸面形状と凸 のに加工機りが存在し、この体の分影響が主なものであ ることが判明した。この様に全ての反射面と反射面との 堤界部分に反射面の形状を有していなない部分があると、 一つの反射面に反射面との形に出来ている加工不良の部 分が小さくても、これらの面積を全て足し合わせると大 きな面積にわたって加工不良が生じているのと同じにな る。

[0010]また、更に、図12と図13と示すような 反射型インテグレータを既存の加工装置で製造しようと すると、反射型インテグレーチの一つの反射面の長さが 長いため、装置のステージの移動量が不足して加工でき ないことが多かった。また、加工できたとしても、長尺 であるために装置の運動精度が原因となって、高い形状 精度が場られないと含う個関係があった。

【0011】 そこで、本処門はこのよう公課題を解決するべく考案したものであり、設計通りの反射面形状を有する多光源院成反射線を歩賀まり良く製造できる製造方法を提供することを第1の目的にし、更には、よりスループットの高い半導体露光装置を得ることを第2の目的にしている。

[0012]

【課題を解決するための手段】上認課題を解決するため に本発明の第1の形態では、所定の曲面の一部を画形状 とする要要反射面を複数形成し、所定の位置に配置して なる反射鏡の製造方法であって、複数の基板を用意し、 各基板に要素反射面を一列づつ加工して要素反射面列を 形成し、要素反射面が形成された基板同士を接合する 工程を有することとした。 【0013】この様に、一つの基板にまず一列の反射面 を形成し、その次に要素反射面列が形成された基板をつ なぎ合わせることで、要素皮射面と要素反射面との間に 出来た加工不負部分を少なくすることができ、反射効率 の負い多面皮積を形成することができ、反射効率 の第1の形像では、要素反射面列が形成された基板同士 の接合は、要素反射面列が上す方向に対して異なる方向 に前記集板同十を接合することした。

【0014】また、本発明の第2の形態では、所定の由 面の一部を面形状とする要素反射面を複数形成し、所定 の位置に配置してなる反射型照明装置であって、要素反 射面が一列・つか形成された復数の素板をそれぞれ接合し たことで形成されたものとした。この様な形態を有する 照明装置であるので、要素反射面同士の填発近勢も設計 通りの面形状に形状加工できるので、有効反射面の面積 が十分広く明るい反射型原理製置が得られる。

[0017]

【発明の実施の形態】次に本発明の第1の実施の形態として、図2に示す投影震光差微に用いられる反射型インデグレータである多面反射競について説明する。この多面反射競は、投影光学系の布する光学視野に合わせて照明視野を設定し、これによって照明効率を上げ、スループットの周囲を解決するものであり、駐しくは同出題人が出版した特願平10-47400号に記載されている。この技術を図2をもとに簡単に説明する。

【0018】回2は、本発明の実施の形態における役影 購光装置の転要回である。この投影購光装置では、光源 1と、多面反射鏡2と、コンデンサー光学素子3と、反 射鏡4と、マスク5と、マスクステージ5sと、及影光 学系6と、ウェハ7と、ウェハーステージコントローラ8を ーラ9が備わっている。

【0019】光源1より出た光は本発明の製造方法を用いて形成された多面反射鏡2に入射する。そして、多面反射鏡2で反射された光は、コンデンサー光学素子3及

び反射線4を経てマスクステージ5 s 上に保持されたマ スク5を照明する。なお、本明練書では多面反射鏡2、 コンデンサー光学業子3及び反射鏡4をまとめて反射型 照明光学系と言う。

[0020] マスク5には、ウェハステージア。 s LE保 持されたウェハ7 Lに描くべきパターンと相似形状のパ ケーンが形成されている。そして、マスク5 Lのパター ンは反射型照明光学系によって照明され、非球面反射鏡 6 a、6 b、6 c、6 dからなる投影光学系をを通じて ウェハ7 Lに投影される。この様にして、マスク5 に形 成されたパターンをウェハ7 Lに投影している。

[0021]ところで、表態光学系6の光学報野は円型 形状であり、製作すべきデバイスチップ全体をカバー出 来るほど広くはなく、マスクとりセンハマを同期させて 相対的に移動(スキャン)させながら露光を行うことに よってチップ全体のパターンをウェハ上に形成する。こ のために、マスクステージ5 s の移動量を制御するレー ザー干渉評職計と含むマスクステージコントローラ8と ウェハステージ7 s の移動量を制御するウェハステージ コントローラ8 が備わっている。(このスキャンを伴う 電光方太に関しては外の事本女飲1を参照)。

【0022】ところで、参画反射鏡2は、光源1からの 光から光学的に複数の2次光膜を形成するためにある。 そして、参画反射鏡2は、それぞれの反射面の暗熱が同 じ複数の微小な要素反射面を面形状態に織り返し 胚列されている。なお、要素反射面の那形状能に織り返し 配列されている。なお、要素反射面の外形状は投影と 系の光学発度形状と相似形にしている。これによって位 置 P 2 に多数の点光照像 1 が形成され、これがコンデン サー光学業子3 によって必要な照明視野を形成する。 E 2 にあまりな操作が形成され、これがコンデン サー光学業子3 によって少要な照明視野を形成する。 E 2 にあまりな技術を用いると、マスク上の原明すべき領域 を無駄無く一様に照明出来、露光時間の短縮が可能になって、高いスループットを有する半導体露光装置の実現 が可能になる。

【0023】上記の様な、円弧状の照明現野を有する反 射型照明光学系に用いられる多面反射鏡2と、その多面 反射鏡2に形成される一つの要素反射面を実際に設計した結果を図3、4を用いて説明する。図3に示すよう に、この参面反射鏡2は3種類の要素反射面(A1、B 1、C1)から構成されている。そして、それぞれの要 素反射面の一辺を合わせて列をなして設けられている。 そして、この様な列を形定の数の列分形成して、多面反 射鏡2を形成している。ところで、多面反射鏡2の各列 は、要素反射面が私1、B1、C1、A1、B1、C1 …の順に配列されている。そして、各要素反射面の面形 状体、定の曲率を有する凹面に関4 (a) (b) (c)に示した形状を投影したときの形状を有してい

【0024】図4に示された凹面41は、焦点距離が図 2に示すP2の距離と同じ距離を有する球面である。こ の回面41に形成された球面に、図4に示すようにYZ 面に平行な円鑑状件(平均半径がZhの円の円弧状件) を投影した那状と同じ形状を舎要素反射面は有している。そして、要素反射面A1の形状は、投影する円弧の 門の中心を、四面41の球面の中心軸に合わせたときの 投影像と同形状である。また、要素反射面B1、C1の 形状は、投影する円弧の中心を、凹面41の球面の中心 他に対して乗点方向にYhをプザラしたとをの投影像と 同形状である。この様な形状は、いずれもほぼ円弧状に なる。城面に対して垂直方向から見れば完全な円弧状で ある。

【0025】このようにして出来た要素反射而に、例え 採 X 方向より平行光線を入射させると要素反射而 A 1 に よる点像が明而41の球面の混点位置と同じ化質に形成 され、要素反射面 B 1 による点像が焦点位置とり Y h だ け横ずわして形成される。また、要素反射面 C 1 による 点像も同じく基板41の球面の無点位置より - Y h だけ 横ずれして形成される。

【0026】なお、要素反射菌の好適な実用的な設計解 としては、要素反射菌の歯率半径Rは160~2000 mm、図4にディアもの原盤は4.5~555mm、円弧 の幅 (円弧状帯の幅) は0.3~20mm、円弧の長さ は4.5~55mm、図4(b)(c)にデナトは約 2.3~27mmとなり、更に表面視さが1ms<0.3 3nmである。

【0027】ところで、図3に示した多面反射鏡2を、従来の技術のように一枚の基板からボールエンドミルを 億未免期所工地差中ルで可加工して製造すると、図 5に示すような形状になる。このように、各要素反射面 51同土が互い隣接している部分に加工残りのRが存在 し、この部分に開射された光が所定の位置に反射してこないことが判明した。このように所定の位置に反射してこないことが判明した。このように所定の位置に反射してこない光が有ると、マスク5に照明される光虚が低下 し、ウェハーてへの露光等間が長くなる。その結果、スループットが低い露光装置になってしまう。

【0028】この様なことを解決するために、本発明の 第1の実施の形態である多面反射鏡の製造方法では、図 6に示すように、一つの基板上に要素反射面を一方向に 一列に形成する。そして、基板の幅を要素反射面の幅と 同じ寸法にすることで、エンドミル31が要素反射面の 境界部分に末でも、そのまま矢印32の方向に切削しな がら移動できる。

【0029】この様にして要素反射面A1、B1、C1 が形成された基板を複数形成し、次に、要素反射面が形成された基板を複数所成し、次に、要素反射面が形成 成された基板を配列することで多面反射線2を形成すること ととした、複数の基板に要求以前電形成することによって、1個の要素反射面の加工に失敗したとしても、加 工に失敗した要素反射面を形成するとである。 ドミル31が要素反射面51の形成領域の隅を通過しな がら加工できるので、四隅に加工残りが生じることな く、高い形状精度を有する光学素子が加工できる。

【0030】 次に、本祭明の実施の形態にかかる多面以 対鏡の製造方法を詳しく説明するものとする。まず、金 風のブロック、例えば、無疾素観のブロックを準備す る。ここで、無酸素細を選択した理由は、切削および研 をした場合に鏡点性が優れているためである。このプロ ックを所述の大きさに切り出す。その大きさは、要素反 射面が一列の形成できる程度の大きさを有しており、か か他の要素皮料画列が形成された裏板を接合することを 考えて、切り出す裏板の模幅は、要素反射画の円弧形状 に対する粒の長さと同じにしている。なお、本実施の形 能では無無常列のブロックから、長さ30mのボ m ×高さ10mmのブランク1個と、長さ27mm×幅 5mm×高さ10mmのブランク2個に切り出した。 100311次に、この切りだされたブランのうち、

1個のプランクを、ボールエンドミルを備えた切削加工 機に取り付け、図3に示す3種類の要素反射面A1、B 1、C1の形状を1つずっ形状加工する。形状加工を行 った後は、研磨を行うことにより、要素反射面列を鏡面 状態とした。

【0032】この様にして、一つの基板に複数の要素反射面が一方向に配列されるように形成された要素反射面列を形成した。そして、他のプランクにも間しように切削加工機により形状加工と研磨を行い、一つの基板に数数の要素反射面が4元が成した。安果反射面列を形成して、合計3つの要素反射面列を形成した。この様にして形成された要素反射面列25、26、27年、図1に示した形状となる。次に、この要素反射面列25、26、27年、要素反射面列25、26、27年、201に同じに形状となる。次に、この要素反射面列25、26、27年、安素反射面列25、26、27年、安素反射面列25、26、27年、安素反射面列25、26、27年、公素正反射域25年、5年に関すによった。

【0033】この様にして形成された多面反射鏡2は、更に反射率を上げるために、反射板を形成する。例えば、この多面反射鏡2が前途の端光装置に用いられ、かつその震光装置の光振として、F2レーザを用いた場合、多面反射鏡2にアルミニウム原の検性防止と反射率の維持の販点から、フッ化マグネシウム(MgF2)を数十ヵmの厚くに成成することが対ましい。

【0034】また、軟X綿線域の光(電磁波)を使用する場合には、モリブデンとケイ素の交互多欄吸を形成することが好ましい。この様にして、露光装置に用いられる多面反射強2が形成でき、要素反射面の原果部分も所望の形状に形成されているので、有効の反射面が広く明るい反射治学等を形成されることができる。また、要素反射面の形成時や形成後に、一つの反射而に不良側所が生じた表板のみを作り直じたとしても、その不良板所が生じた基板のみを作り直

して、交換するだけで良いのでコストを安く抑えること ができる。

【0035】なお、本郷明は上述で示した形状を有する 多面反射鏡以外でも適用可能である。例えば、要素反 射面はA1. B1、C10の種類よりも多くでも、少な くとも良く、また、要素反射面は非球面の一部でも良 い。また、要素反射面対も3列に限られたものではな い。また、他の全く異なった形状の反射鏡についても本 製造方法は適削できる。

【0036】次に、本発明の第2の形態として、図12 に示すような野枝の多面反射線の製造力技を思明する。 のような形状を有する多面反射線では、一つの基板に 多数の反射面を形成すると、どれか一カ所不良箇所が生 じた場合、他のほい反射面も破棄せざるをえなくなるの で、複数の要素反射面列を形成し、そして、その要素反 射面列をつなぎらわせた。

【0037】この場合、反射機の長さによって、図12 で示す集行を方向の長さが長い場合は、一つの要素反射 面の集行きよりも短いブランクを用いる。そして、図7 に示すような要素反射面列71を形成し、それぞれの反 射面が平行に並ぶように20次元的に配置することで、図 12に示す形状の多面反射機が成することができる。 【0038】また、図12で示す集行き方向の長さが短い場合は、一つの要素反射面の集行をと同じ長さのブラクを用いる。そして、図8に示すような要素反射面 81を複数表別と、これを要素反射面が平行に並ぶように 配置することで、図12に示す形状の多面反射鏡を形成 することで、図12に示す形状の多面反射鏡を形成 中できる。

【0039】この様にすることで、コストの低減がはかれ、また、要素反射面列と要素反射面列の境界部分は、 所置の形状に放けることができるので、有効面積を比 較的広くすることができる。なお、更に要素反射面列の 間の加工機りも除去したい場合には、つぎの方法により ブランクを加工することが芽生しい。

【0040】エンドミル31を用いた切削加工機だけで 形成した場合は、図9(a)に示す要素反射面列90の 側面形状と同じ形状を有し、要素反射面列1つ効果が必分 で加工残りCR2が形成されてしまう。そこで、エンド にか31を用いて形成されたしまう。そこで、エンド て、加工残りCR2の部分を押回取工具91で除去す る。この様にして、非回転工具91で加工残りCR2が 防去されたのか形状を図9(b)に示した。この様に して、要素反射面列を形成している要素反射面同士の境 界部においても、有効な反射面形状を形成することがで きる。

【0041】なお、他の方法として、断面形状が要素反射面の境界部分と同形状をした断面形状を持つ非回転工 具92を用いて、要素反射面の境界部分のみ切削することでも構わない。例えば、図9(a)で形成された形状 にものに対し、図10に示すような非回転工具92を別いて、加工残りを除去しても構わない。この様に、要素 反射前列を影成した基板をつざ合わせて、多面反射域 を形成した場合、それでも有効反射面積が小さく、十分 でない場合は、非回転工具により加工残りCR2を除去 することが好ましい。

【0042】 なお、本発明は前述の凸型半円筒形状を有 した多面反射鏡以外にも、図11に示すように要素反射 面列110を複数側形成して、貼り合わせることで、門 型半円筒形状の多面反射鏡の製件に適用できる。この場 合複数の要素反射面列を形成した基板を複数形成し、 それをつなを合わせることで、コスト低減ができる。この を占った法の本発明の実施の影響では、実表身も面の を貼り合わせて、多面反射鏡を形成しているが、本発明 はこれに限られず、多面反射鏡の光学而を上面に向けて 使用するのであれば、単に台座に配列するだけで固定しなくてもよい。また、要素及射面列は、研整を行った後 に接合しているが、本発明はこれに限られず、形状加工 が施された要素反射面列を接合した後に、研修を行った後 に接合しているが、本発明はこれに限られず、形状加工 が施された要素反射面列を接合した後に、研修を行ったも むしい、また、被加工物の対質は無酸素制に、研修を行ったの のではなく、切削・研絡後に酸面性が良好であれば良

【0043】たとえば、シリコン、ULE、スーパーインパー材、無酸素銅、インパー材、アルミニウム、炭素 銅、石炭ガラス、スタバックス材、パイレックスガラス などが考えられる。また、金属基板の上に放映されたニッケル合金の非晶質薄膜やニッケル合金を主成分とする

非晶質薄膜でも良い。

[0044]

【発明の効果】上述のように、本発明によって、多数の 要素皮料面からなる複雑形状の光学素子を高精度で、そ して、高い加工効率で製造できる。また、本製造方法に より得られた反射鏡は、露光装置用の原明装置にもらい れば、スルーブットの高い露光装置が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】:本発明の第1の実施の形態に係る要素反射面 列が形成された基板を接合した多面反射鏡の額略構成図 である。

【図2】:本発明の第1の実施の形態に係る加工手順で 形成された多面反射鏡を使用した露光装置の光学系の概 路構成図である。

【図3】:本発明の第1の実施の形態に係る加工手順で 形成された多面反射輸の概略構成図

【図4】:多面反射鏡を構成する要素反射面の面形状を 示す図

【図5】:従来加工法により形成された多面反射鏡の形

状を示した図である。

【図6】: 一つの基板から要素反射面1A、1B、1C を形成するときにエンドミルの軌跡を示した図であ

【図7】:本発明の第2の形態による加工法で形成され た多面反射鏡の概略構成図である。

【図8】:本発明の第2の形態による加工法で形成され た多面反射鏡の概略構成図である。

【図9】: 本発明の第2の形態による加工法で形成され た場合の加工残りを除去する方法を示した図である。

【図10】:本発明の第2の形態による加工法で形成された場合の加工残りを除去する方法を示した図である。

【図11】: 反射型凹面半円柱型インテグレータの製造 方法を示した図である。。

【図12】:反射型凸面半円柱型インテグレータの概略 図である。

【図13】:反射型凹面半円柱型インテグレータの概略 図である。

【図14】:ボールエンドミルの形状と加工可能な曲面を示した図である。

【図15】:従来の加工法で形成された反射型凸型イン テグレータの断面形状図である。

【符号の説明】

1 ・・・・・ 光源
2 ・・・・・ 多面反射鏡
3 ・・・・・ フンデンサー光学素子
4 ・・・・ 反射鏡
5 ・・・・ マスク、 5 s ・・・・ マスクステージ
6 ・・・・ 投影光学系
7 ・・・・ ヴェハ、 7 s ・・・・ ウェハステージ

8 ・・・・・ マスクステージコントローラ 9 ・・・・・ ウェハステージコントローラ

25、26、27、71、81、90、110 · · · · 要素反射而列

31 ・・・・・ エンドミル

32 ・・・・・ エンドミルの軌跡

41 ・・・・・ 要素反射面の反射面形状を示す凹球

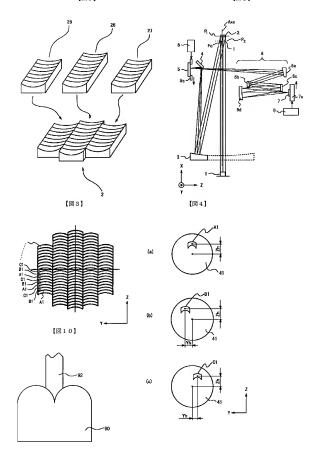
51 ・・・・・ 従来の加工法で形成された要素反射

91、92・・・ 非回転工具

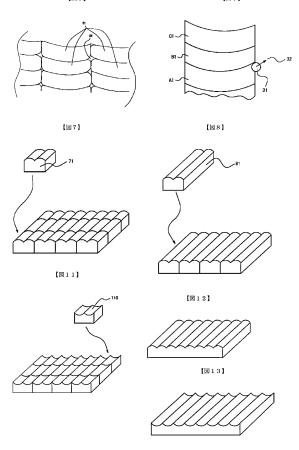
A1、B1、C1・要素反射面

CR CR2 ···· 加工残り

[図1] [図2]



[図5] [図6]



[図9]

